



2026年度中期経営計画

半導体事業本部

2024年5月23日

I	事業概要	P. 3
II	2023年度中期経営計画振り返り	P. 6
III	2026年度中期経営計画	P. 8
	市場動向	
	事業方針・事業計画	
	重点施策（詳細）	
	設備投資・研究開発	

I 事業概要

車の電動化、パワーレ機器の小型化、省エネ、CO2削減などに貢献

電装 (国内 68% / 海外 32%)



電動車・エンジン車

電動車モータ制御、エンジン制御、
トランスミッション制御、ブレーキ制御、
ステアリング制御、等

売上高 (2023年度実績)
2,280億円 (※国内 47% / 海外 53%)

産業モジュール



電装
55%

産業
45%

電装モジュール



電装ディスクリート



産業ディスクリート
感光体



産業 (国内 23% / 海外 77%)



FA(インバータ・サーボ) 空調(ルーム/業務エアコン)



再エネ (風力・太陽光発電) PCS



薄型TV



ミニUPS



プリンター

※売上構成比は2023年度実績。
セグメント間の内部取引等を消去・調整する前の金額に基づき算出。

産
業

モータードライブ(FA,空調他)



IGBTモジュール



再生可能エネルギー



IGBT/SiCモジュール



- 第7世代IGBTによる低損失
 - RC-IGBT*1による小型・高出力
- ⇒ IGBTモジュールで世界シェア第3位

電
装

電動車
(フルハイブリッド / 電気自動車)



IGBT/SiCモジュール



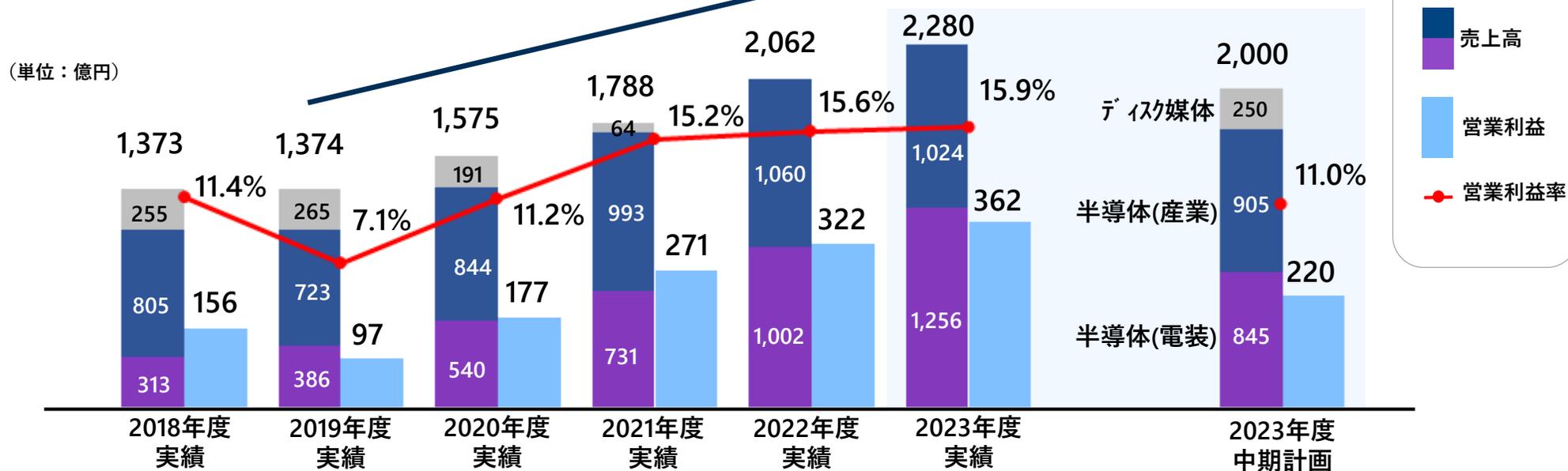
- SiC-MOSFETによる低損失と
使い易さの両立

*1 RC-IGBT：逆導通型IGBT、IGBTチップとFWDチップを1チップ化したもの

II 2023年度中期経営計画振り返り

中期計画に対し売上は1年、営業利益は2年前倒しで達成、23年度業績は過去最高を更新

ディスク媒体の事業撤退影響を打ち返し、
パワー半導体ビジネスで大きく拡大



成 果

- パワー半導体の売上2倍 (対18年度比)
- 電装分野の売上拡大 (23年度：対18年度比 約4倍)
- Si 8インチ生産能力拡大 (23年度末：対18年度末比 5倍強)

課 題

- 拡大する電動車市場で更なる売上拡大
- SiC、Si 8インチの生産能力拡大
- 第8世代IGBTと第3世代SiCの早期開発

III 2026年度中期経営計画

産業：再エネを中心に市場伸長する見込み

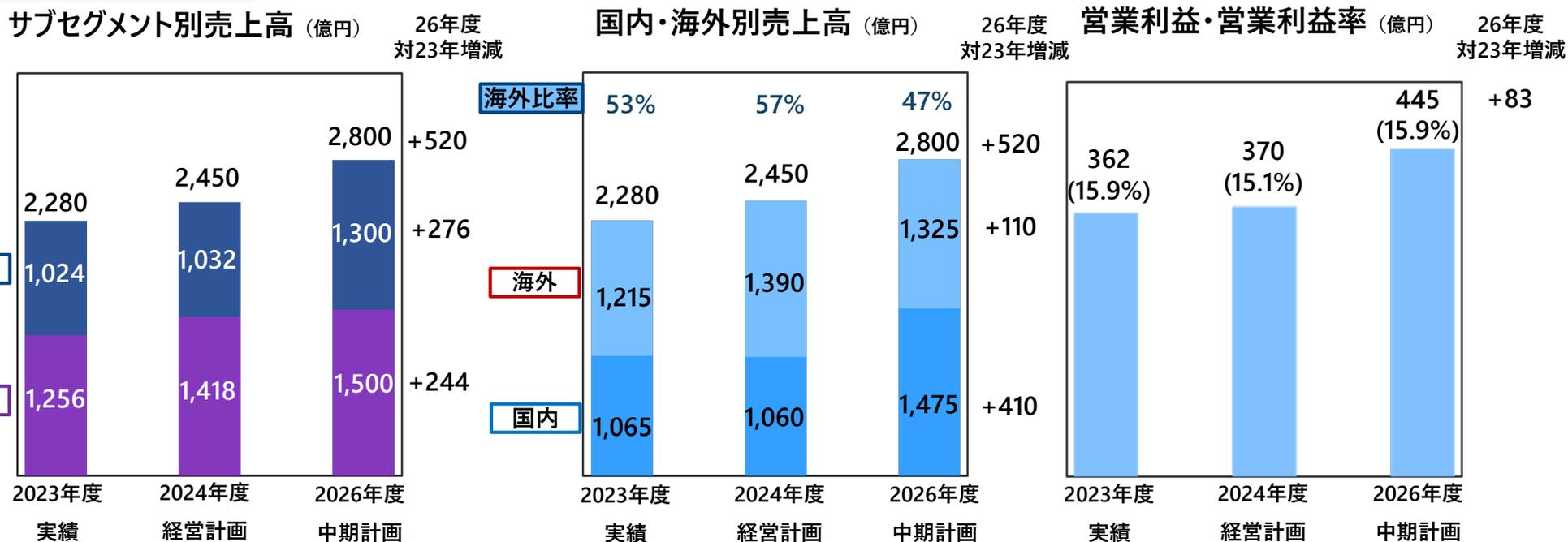
電装：電気自動車の伸びは足元鈍化するものの、電動車全体は大きく伸長

事業分野	市場動向（2024年度～2026年度）		
産業	FA	24年度中盤までは調整局面が続くが、下期以降に設備投資が回復し市場伸長する見込み	
	再エネ	脱炭素化に向けた動きは変わらず、好調を持続する見込み	
	民生他	民生機器、空調機器等も24年度は低成長となるが26年に向けては市場回復となる見込み	
電装	電動車	電気自動車(BEV)の伸長は足元鈍化するものの、電動車全体としては大きく伸長する見込み	
	エンジン車	電動車へ移行する傾向は変わらず、減少する見込み	

事業方針

成長領域（電動車・再エネ）への確実なスペックインによる売上の拡大
SiCの需要拡大に向けた生産体制の構築

事業計画



- 電装分野

- 拡大する電動車市場でSiCを中心に売上拡大

- 産業分野

- 好調な再エネ市場を主体に第7世代IGBTの売上拡大

- ものづくりの強化

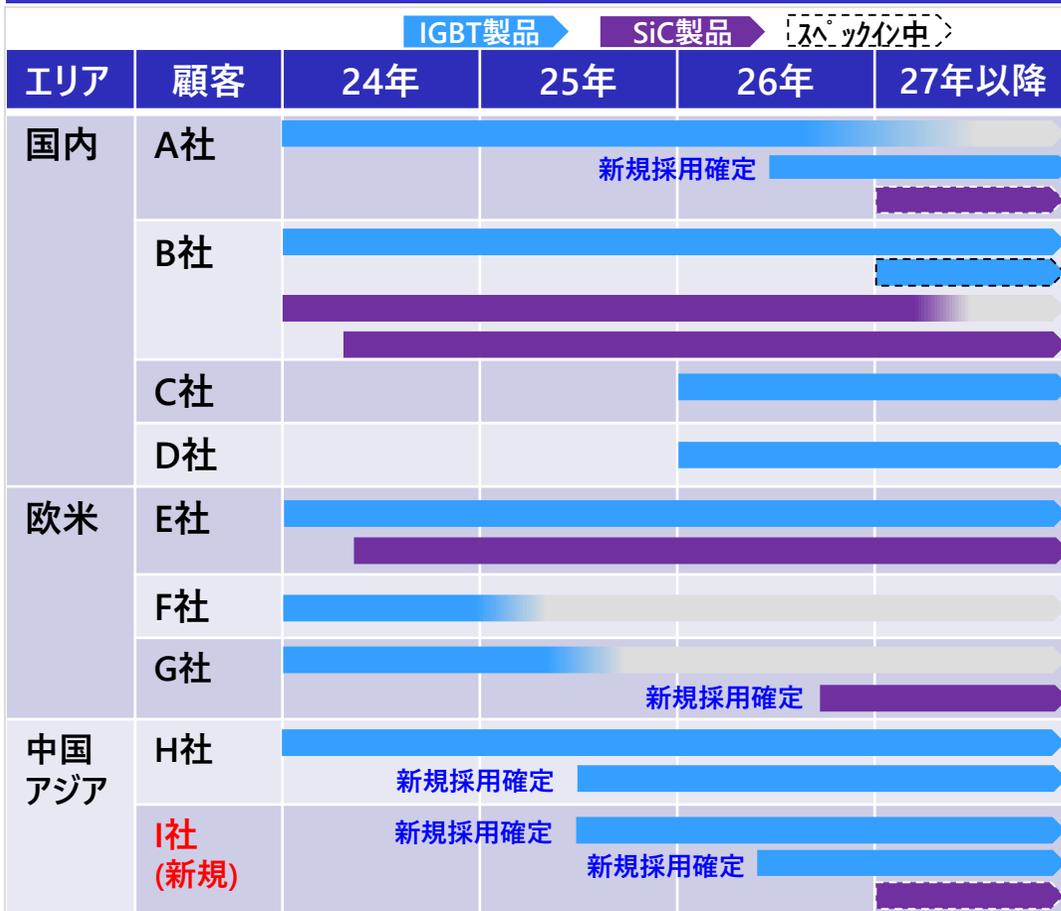
- 前工程：Si 8インチ及びSiCの生産能力増強
- 後工程：電動車向けSiCモジュールの量産ライン構築
産業向けIGBTモジュールの生産能力増強及び生産品目拡大

- 競争力のある新製品の開発

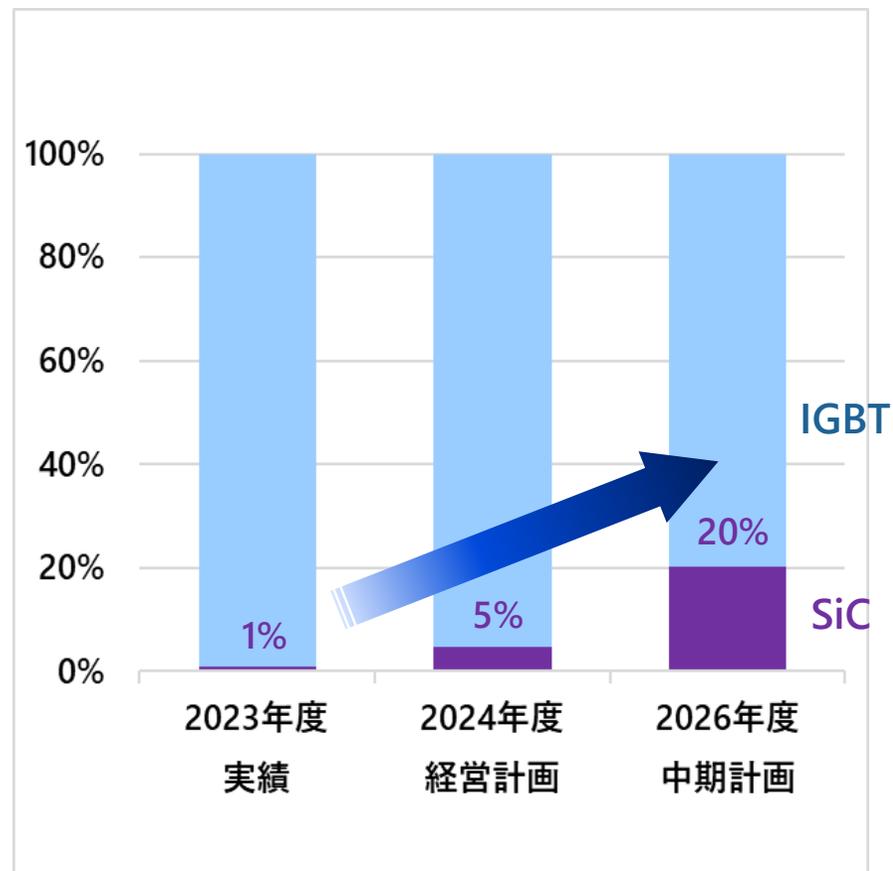
- 電動車及び産業 (大容量) 向けIGBT, SiCモジュールの開発及び量産化
- 第3世代SiC-MOSFETの開発
- 第8世代IGBTの開発

- ターゲット顧客に対し、スペックインを推進中
- SiC採用車種の拡大及び新規採用により、SiCの売上比率は26年以降急拡大

電動車向け IGBT, SiCの新製品採用計画

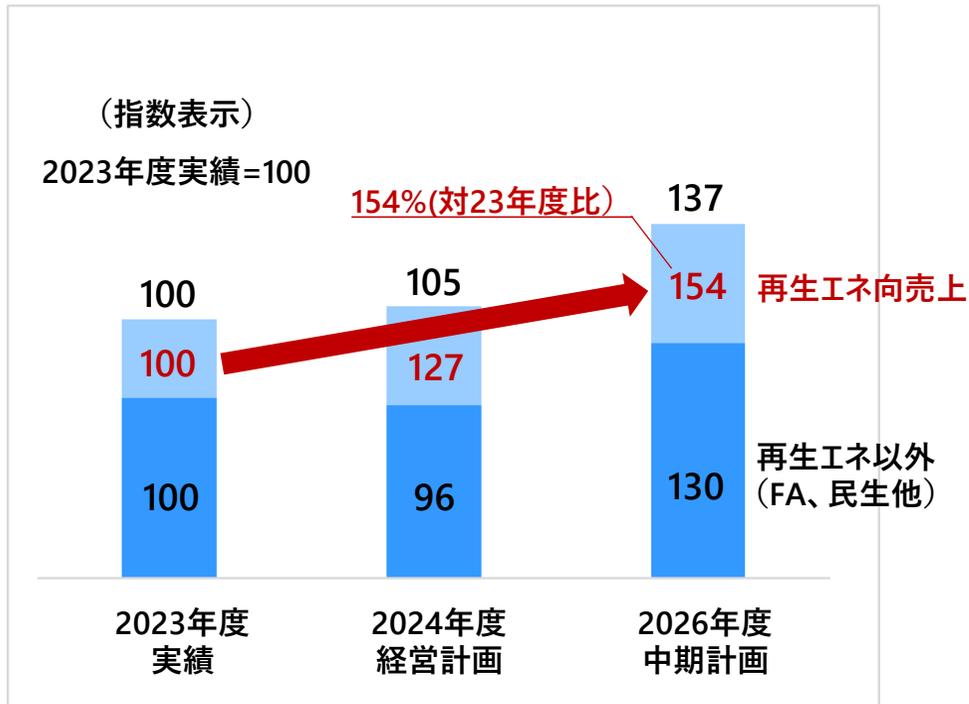


電装モジュール売上構成比率

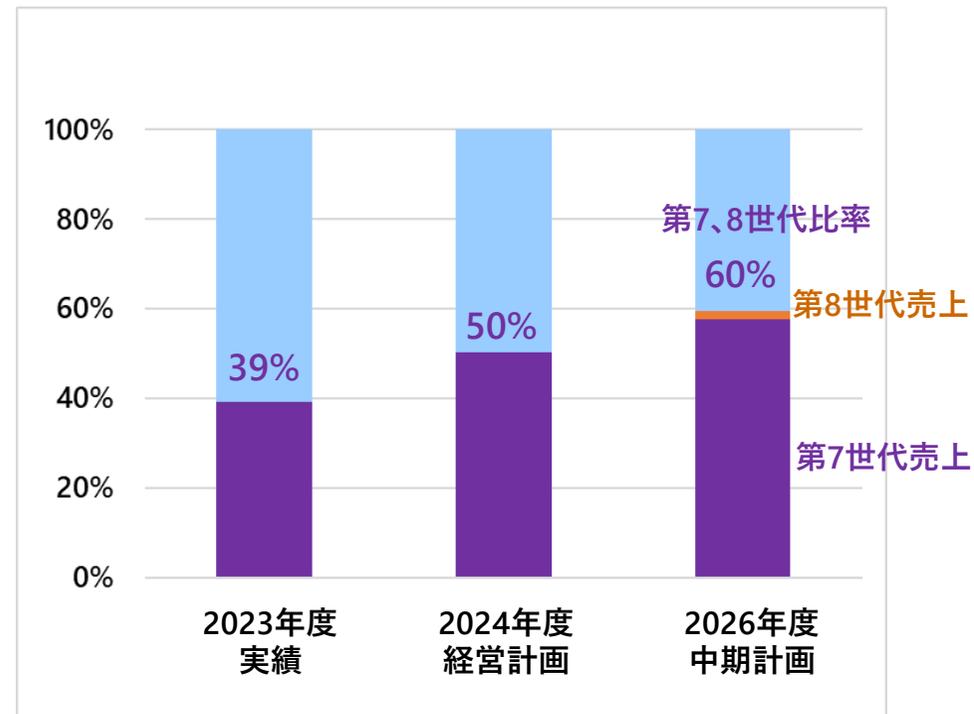


- 再エネ向け：業界主要顧客でのシェアアップにより売上を拡大
- 第7,8世代IGBTの売上比率拡大 (26年度：60%) ※第8世代 2025年度末売上開始

用途別売上高推移



産業IGBT売上構成比率



拠 点



松本

- ・マザー工場
- ・第8世代IGBT 25年度量産開始
- ・SiC 25年度以降 能力増強



山梨

- ・Si 8インチ主力工場
- ・電動車向けIGBT、第7世代IGBT



津軽

- ・SiC 24年度量産開始
25年度能力増強



マレーシア

- ・Si 8インチ 24年度能力増強
(23年度より量産開始済み)

施 策

- ・Si 8インチ能力増強（マレーシア） 及び 新製品対応
- ・SiC 6インチ 24年度 本格量産開始（津軽） と 能力増強（松本・津軽）

- Si 8インチ：26年度に向け生産能力増強（対22年度比+35%）
- SiC：24年度本格量産、26年度に向け大幅増強を推進中

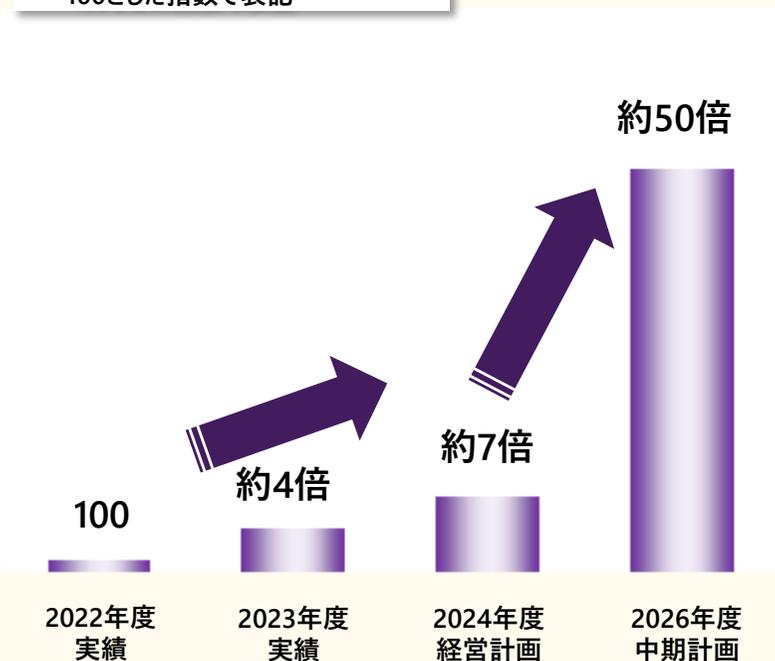
前工程：Si 8インチ生産能力

※ 各年度末の生産能力を2022年度を100とした指数で表記



前工程：SiC 6インチ生産能力

※ 各年度末の生産能力を2022年度を100とした指数で表記



拠 点



国内（3拠点）

- ・組立製品のマザー工場
- ・国内顧客向け製品の生産拠点
 - ： 電動車向けモジュールの能力増強
 - ： 第8世代IGBT生産開始（25年度）



フィリピン

- ・ディスクリート製品及びエアコン向けモジュールの主力拠点
- ・第7世代IGBT生産開始（25年度）



中国(深セン)

- ・中国顧客向け産業IGBTモジュール生産拠点
 - ： 第7世代IGBTの能力増強



マレーシア

- ・欧米顧客向け産業IGBTモジュール生産拠点
 - ： 第7世代IGBTの能力増強

施 策

- ・地産地消を推進、フィリピンで産業向けIGBTモジュールの生産開始（25年度）
- ・電動車向けモジュールの能力増強と新製品立上げ
（23年→26年：約35%増 ※年度末比較）
- ・産業向け第7世代IGBTモジュール能力増強と生産品種拡大
（23年→26年：約3割増 ※年度末比較）

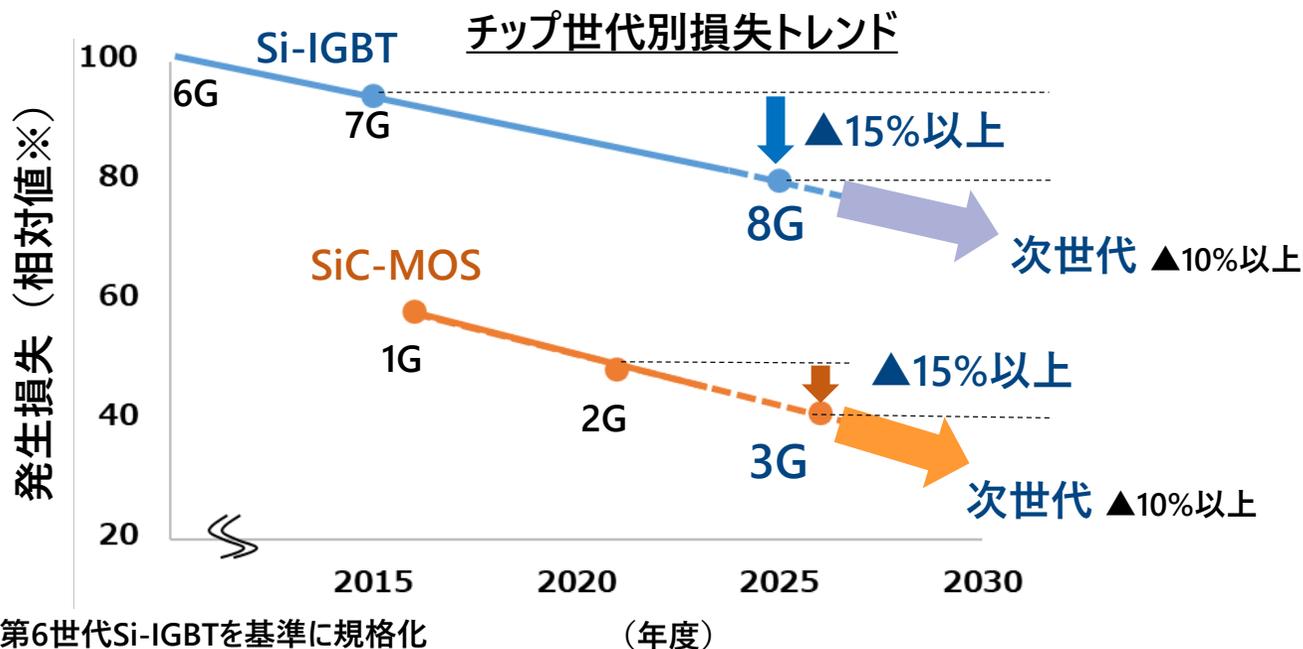
● 第3世代SiC-MOSFET、第8世代Si-IGBTチップの新製品開発、次世代技術の開発を推進

SiC-MOSFET

- 第3世代SiC MOSFET（26年度量産開始）
 - ・対第2世代比▲15%以上の低損失
 - ・750～3300V耐圧製品の系列化
- 次世代SiC MOSFETの技術開発
 - ・対第3世代比▲10%以上の低損失

Si-IGBT

- 第8世代IGBT（25年度量産開始）
 - ・対第7世代比▲15%以上の低損失
- 次世代IGBTの技術開発
 - ・対第8世代比▲10%以上の低損失



競争力のあるモジュール製品の開発

- 第8世代IGBT、第3世代SiCの技術を適用したモジュール製品の開発を推進
- 高密度実装技術、高温動作化等により出力密度を向上

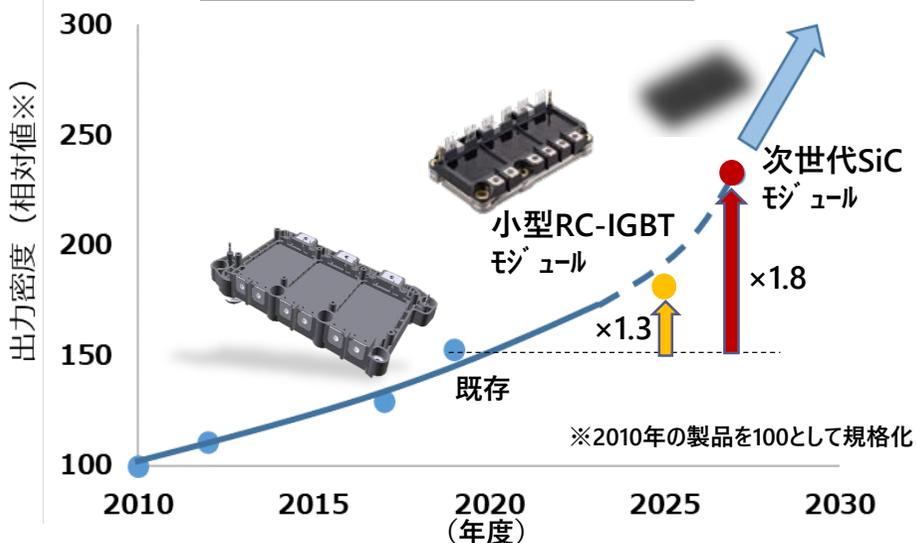
電動車向けモジュール

- 小型RC-IGBTモジュール (25年度量産開始)
 - ・ RC-IGBTと高密度実装技術による出力密度向上
- 次世代SiCモジュール (26年度量産開始)
 - ・ 3G-SiCと立体配線技術による出力密度向上

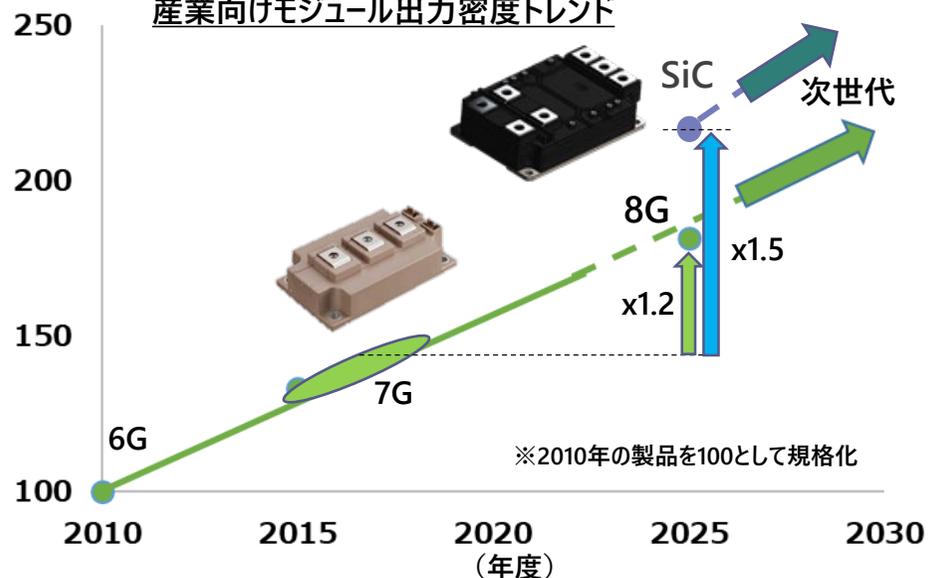
産業向けモジュール

- 第8世代IGBTモジュール (25年度量産開始)
 - ・ 8世代IGBTと高温動作化による出力向上
- 大容量SiCモジュール (25年度量産開始)
 - ・ 3G-SiCと低インダクタンスパッケージにより損失を大幅減
⇒ 高出力密度化によりインバータの出力拡大に貢献

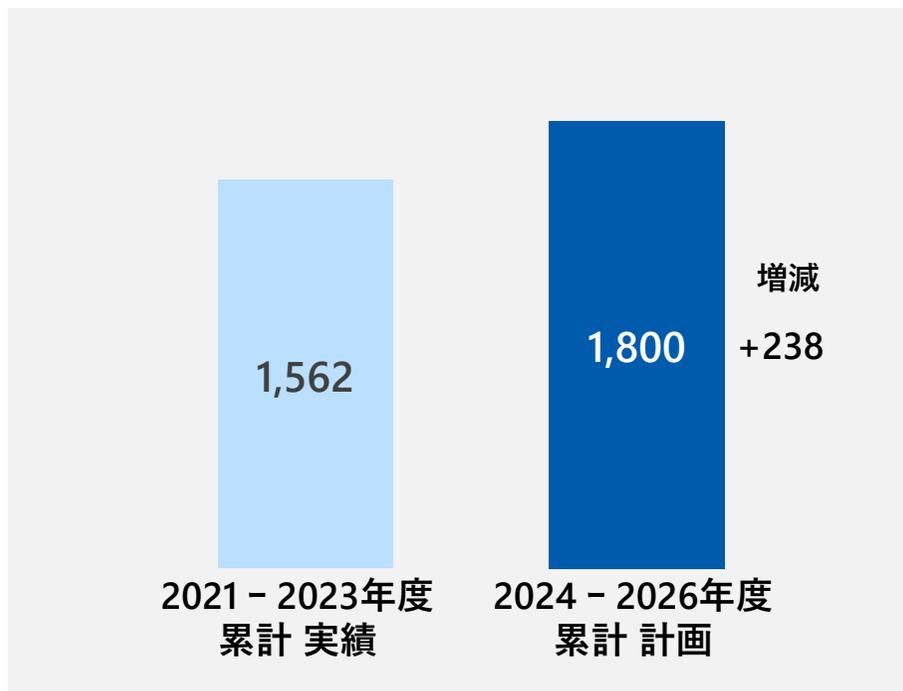
電動車向けモジュール出力密度トレンド



産業向けモジュール出力密度トレンド

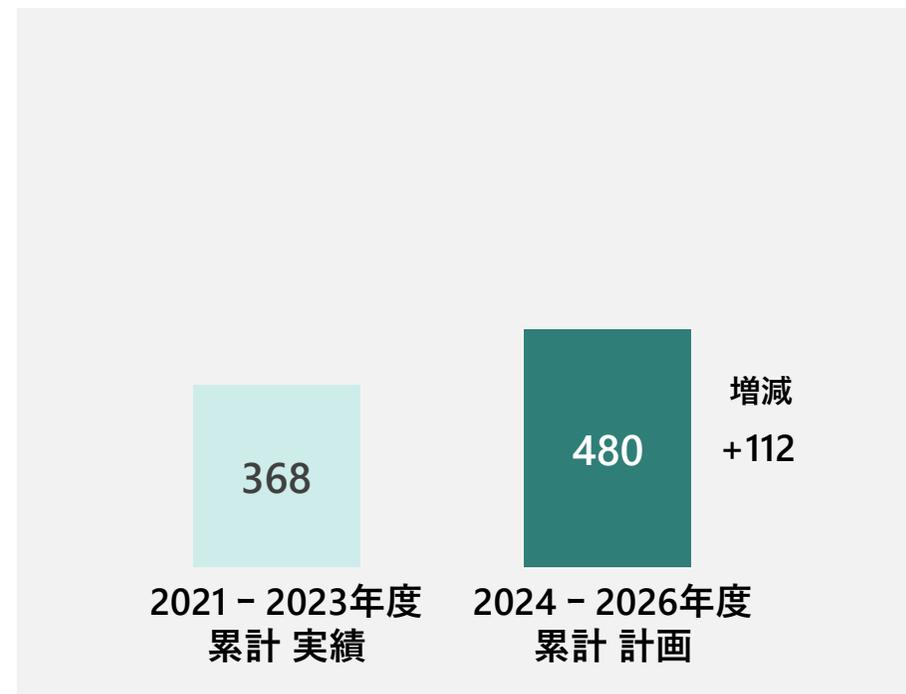


設備投資 (億円)



- 前工程 生産能力増強 (SiC、IGBT 8インチ)
- 後工程 生産能力増強 (電動車向け及び産業向けモジュール)

研究開発 (億円)



- 電動車向け及び産業向けSiC/IGBTモジュール
- 第3世代SiC-MOSFET及び第8世代IGBTの技術開発
- SiC 8インチ量産技術開発

1. 本資料及び本説明会に含まれる予想値及び将来の見通しに関する記述・言明は、弊社が現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいております。その判断や仮定に内在する不確実性及び事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なる可能性があり、弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、その確実性を保証するものではありません。
2. 本資料は、情報の提供を目的とするものであり、弊社の株式の売買を勧誘するものではありません。
3. 目的を問わず、本資料を無断で引用または複製することを禁じます。